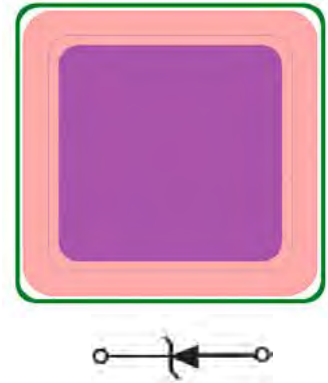


概述

- LM605ESDP25-0.4 是利用先进的硅电路工艺生产的单向普通电容静电放电保护器件。
 - 低钳位电压;
 - 快速的响应速度;
 - 低漏电流 (<100nA);
- IEC6100-4-2(ESD); +/-30KV(空气放电); +/-30KV(接触放电)



芯片信息

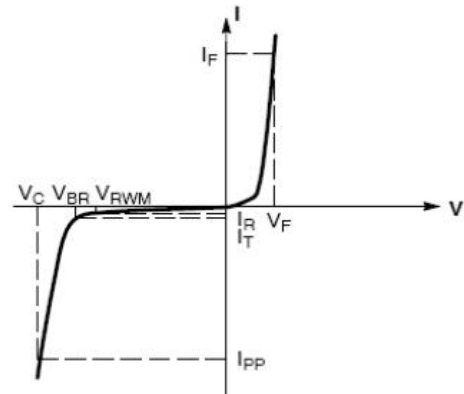
项目	描述
流片代码	KID069
圆片尺寸	6Inch
有效管芯数	98000dies wafer
芯片尺寸	400umx400um
压点尺寸	340um*340um
芯片厚度	150±10um
正面金属	Al:3um
背面金属	Ti/Ni/Ag 或 Ti/Ni/Sn/Ag
划片道宽度	50um

极限参数 (T_{amp}=25°C)

参 数	符 号	额定值	单 位
芯片最高工作温度范围	T _{opr}	-55 ~ +150	°C
芯片最高存储温度范围	T _{stg}	-55 ~ +150	°C

电性参数 (T_{amp}=25°C)

Symbol	Parameter
I _{PP}	Maximum Reverse Peak Pulse Current
V _C	Clamping Voltage @ I _{PP}
V _{RWM}	Working Peak Reverse Voltage
I _R	Maximum Reverse Leakage Current @ V _{RWM}
V _{BR}	Breakdown Voltage @ I _T
I _T	Test Current
P _{pk}	Peak Power Dissipation
C	Capacitance @ V _R = 0 and f = 1.0 MHz



Item	Symbol	Test Conditions	Criterion			Unit
			Min	Typ	Max	
正向压降	V _F	I _F =10mA			1.1	V
最大峰值功率	P _{PK}	I _{pp} =25A, t _p =8/20us			325	W
维持电压	V _{RWM}				5	V
击穿电压	V _{BR}	I _t =1mA	6		8	V
漏电流	I _R	V _{RWM} =5V			1	uA
钳位电压	V _C	I _{pp} =20A, t _p =8/20us			11	V
钳位电压	V _C	I _{pp} =25A, t _p =8/20us			13	V
电容	C _j	V _R =0V, f=1Mz		163		pF

注意事项:

- 芯片存储条件 (推荐): 氮气保护, 温度 25±5°C, 湿度 ≤45%;
- 封装时, 请将距离圆片边沿 4mm 及以内位置的管芯剔除;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行通知! 请客户下单前向销售人员索取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用中微晶园产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

NOTICE

Leiditech reserves the right to make modifications, enhancements, improvements, corrections or other changes without further notice to any product herein. Leiditech does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein.